

GaAs MMIC吸收式单刀双掷开关芯片, DC-6GHz

性能特点:

- 频率范围: DC-6GHz
- 插入损耗: 1.3dB
- 隔离度: 56dB
- 开态驻波比: 1.2
- 50Ohm 输入/输出
- QFN4X4mm

产品简介:

QSSW0006DT-C4是一种GaAs MMIC吸收式单刀双掷开关,输入/输出端50Ω匹配,频率范围覆盖DC~6GHz,采用0V/-5V加电,开关速度10ns。该放大器采用4X4mm表贴无引线陶瓷管壳,可实现气密级封装,引脚焊盘表面采用镀金工艺处理,适用于回流焊安装工艺。

使用限制参数¹

控制电压范围	-8V~+0.5V
最高输入功率	+34dBm
工作温度	-55 ~ +85°C
存储温度	-65 ~ +150°C

【1】 超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

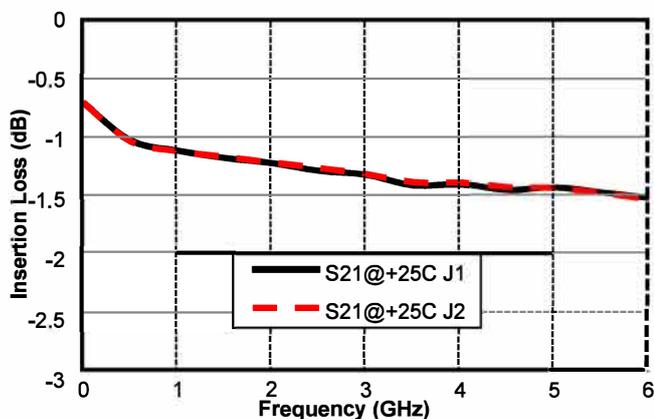
电性能参数(T_A= +25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC-6			GHz
插入损耗	-	1.3	-	dB
隔离度	-	56	-	dB
输入回波损耗	-	22	-	dB
输出回波损耗	-	23	-	dB
P-1dB	-	33	-	dBm
开关速度	-	10	-	ns

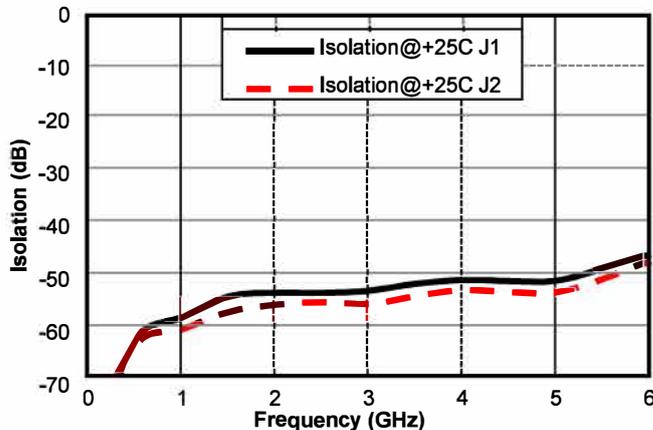
GaAs MMIC 吸收式单刀双掷开关芯片, DC-6GHz

主要指标测试曲线

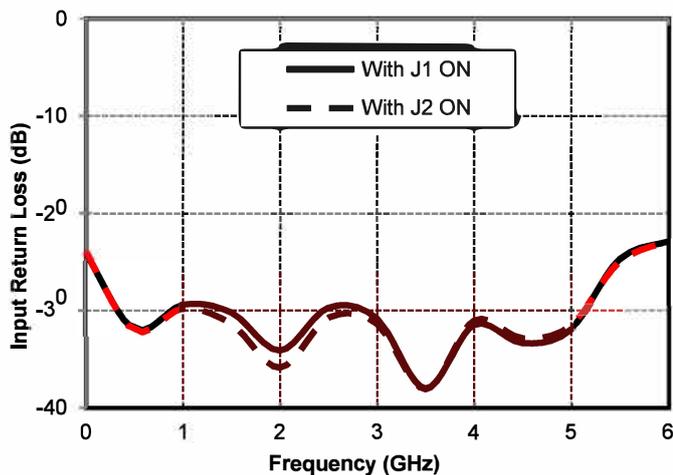
插入损耗 vs. 工作频率



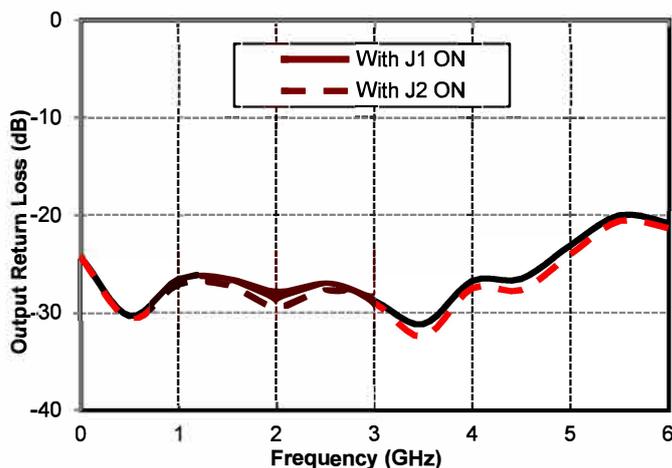
隔离度 vs. 工作频率



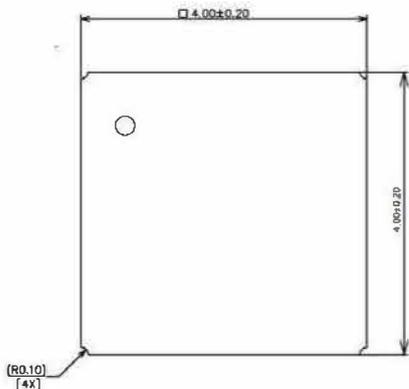
输入波损耗 vs. 工作频率



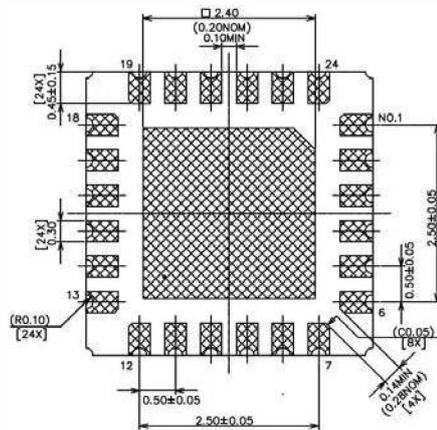
输出回波损耗 vs. 工作频率



外型结构



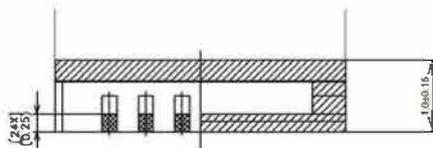
俯视图



俯视图

GaAs MMIC 吸收式单刀双掷开关芯片, DC-6GHz

外型结构



侧视图

图中单位均为毫米。

真值表:

VC1	VC2	RFC-RFO1	RFC-RFO2
-5V	0V	关闭	导通
0V	-5V	导通	关闭

管脚定义

管脚序号	功能符号	功能描述
3	RFC	射频信号输入端
10、21	RF1、RF2	射频信号输出端
7、8、23、24	VC1、VC2	导通、关断控制
2、4、9、11、20、22	GND	管脚与射频、直流地需充分良好接触
芯片底部	GND	芯片底部与射频、直流地需充分良好接触
其他	NC	管脚悬空, 可以接地

使用时, VC1, VC2 使用其中任意一组即可。

应用电路

